

2. have a maximum of 8,192 bits per package,
3. have a maximum access time of not less than 450 ns, and
4. are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C ,

(VI) bipolar RAMs that have

1. a maximum of 64 bits per package and a maximum access time of not less than 30 ns,
2. a maximum of 256 bits per package and a maximum access time of not less than 40 ns, or
3. a maximum of 1,024 bits per package and a maximum access time of not less than 45 ns,

(VII) MOS DRAMs that

1. have a maximum of 4,096 bits per package,
2. have a maximum access time of not less than 250 ns, and
3. are not rated for operation at ambient temperatures below -20°C or above 75°C , and

(VIII) MOS SRAMs that have

1. a maximum of 1,024 bits per package, and
2. a maximum access time of not less than 450 ns,

(K) amplifier monolithic integrated circuits, multichip integrated circuits, film-type integrated circuits or hybrid integrated circuits that are

(I) audio amplifiers that have a maximum rated continuous power output of 50 W or less at an ambient temperature of 25°C and that are capable of operating at an ambient temperature above the upper temperature limit of 85°C ,

(II) instrumentation amplifiers that have

1. a best-case rated linearity of not better than ± 0.01 per cent at a gain of 100,
2. a maximum gain bandwidth product of not more than 7.5, expressed in megahertz, and
3. a typical slew rate at unity gain not greater than $3\text{ V}/\mu\text{s}$,

(III) isolation amplifiers,

(IV) operational amplifiers that have

1. a typical unity gain open-loop bandwidth of not more than 5 MHz,
2. a typical open-loop voltage gain of not more than 10^6 , that is 120 dB,
3. a maximum
 - a. intrinsic rated input offset voltage of not less than 1.0 mV, or
 - b. input offset voltage drift of not less than $5\ \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$,
4. a typical slew rate at unity gain not greater than $6\text{ V}/\mu\text{s}$, and

2. ont un nombre maximum de 8 192 bits par boîtier,
3. ont un temps d'accès maximal d'au moins 450 ns,
4. ne sont pas prévues pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures à -20°C ou supérieures à 75°C ,

(VI) une ou plusieurs RAM bipolaires qui à la fois:

1. un maximum de 64 bits par boîtier et un temps d'accès maximal d'au moins 30 ns,
2. un maximum de 256 bits par boîtier et un temps d'accès maximal d'au moins 40 ns,
3. un maximum de 1 024 bits par boîtier et un temps d'accès maximal d'au moins 45 ns,

(VII) une ou plusieurs MOS-DRAM qui à la fois:

1. ont un maximum de 4 096 bits par boîtier,
2. ont un temps d'accès maximal d'au moins 250 ns,
3. ne sont pas prévues pour fonctionner à des températures ambiantes inférieures à -20°C ou supérieures à 75°C ,

(VIII) une ou plusieurs MOS-SRAM qui ont à la fois:

1. un maximum de 1 024 bits par boîtier,
2. un temps d'accès maximal d'au moins 450 ns,

(K) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides amplificateurs qui sont:

(I) des amplificateurs basse fréquence ayant une puissance de sortie nominale maximale continue d'au plus 50 W à une température ambiante de 25°C et pouvant fonctionner à une température ambiante supérieure à 85°C ,

(II) des amplificateurs d'instrumentation qui ont, à la fois:

1. une linéarité nominale dans le meilleur des cas d'une précision maximale de $\pm 0,01$ pour cent pour un gain de 100,
2. un produit maximal gain-bande passante d'au plus 7,5 exprimé en MHz,
3. un accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité, ne dépassant pas $3\text{ V}/\mu\text{s}$,

(III) des amplificateurs d'isolement,

(IV) des amplificateurs opérationnels qui à la fois:

1. ont une bande passante typique de gain unité en boucle ouverte d'au plus 5 MHz,
2. ont un gain en tension typique en boucle ouverte d'au plus 10^6 , c'est-à-dire 120 dB,
3. répondent à l'un des critères suivants:
 - a. une tension résiduelle d'entrée maximale nominale intrinsèque d'au moins 1 mV,
 - b. une dérive de la tension résiduelle d'entrée maximale d'au moins $5\ \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$,
4. ont un accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité, d'au plus $6\text{ V}/\mu\text{s}$,